а 2008 0056

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, в частности к газовым датчикам, и может быть использовано для детектирования токсичных газов в атмосфере.
Газовый датчик на основе стеклообразных халькогенидных полупроводников включает изолирующую подложку, на которой последовательно расположены электродный слой, газочувствительный слой и электрод с малой площадью. Причем газочувствительный слой представляет собой наноразмерную пленку, осажденную методом испарения в вакууме As_2S_3, As_2Se_3, или их твердых растворов, а поверхность пленки выполнена пористой посредством химического травления.

П. формулы: 1
Фиг.: 3